

СПИНОВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ИМПУЛЬСАМИ НЕПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА В НИЗКОСИММЕТРИЧНЫХ КВАНТОВЫХ ЯМАХ

B. A. Горелов, С. А. Тарасенко, Н. С. Аверкиев*

*Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук
194021, Санкт-Петербург, Россия*

Поступила в редакцию 20 декабря 2010 г.

Исследована спиновая динамика электронов в низкосимметричных квантовых ямах в условиях межзонного возбуждения ультракороткими импульсами неполяризованного света. Показано, что после прохождения светового импульса через время, сопоставимое с временем релаксации импульса электронов, в системе возникает спиновая поляризация, которая затем исчезает. Микроскопическая теория спиновой ориентации электронов оптическими импульсами, несущими нулевой угловой момент, развита для асимметричных квантовых ям, выращенных из полупроводников с решеткой цинковой обманки вдоль кристаллографического направления [110]. В таких структурах накачка неполяризованным светом в геометрии нормального падения приводит к возникновению спина в плоскости квантовой ямы вдоль оси [110].

1. ВВЕДЕНИЕ

Разработка эффективных методов спиновой ориентации носителей заряда в низкоразмерных системах относится к основным направлениям развития полупроводниковой спинtronики. Широкое распространение получили оптические методы создания и детектирования неравновесной спиновой поляризации, основанные на спин-зависимых правилах отбора для межзонных оптических переходов [1, 2]. Механизмы спиновой ориентации электронов и дырок при оптическом возбуждении циркулярно поляризованным светом хорошо изучены экспериментально и теоретически для объемных полупроводников и полупроводниковыхnanoструктур [3–5]. Переход от объемных кубических материалов к nanoструктурам на их основе приводит к усилению роли спин-орбитального взаимодействия. Благодаря разнорному квантованию, оптическая ориентация спинов носителей заряда в nanoструктурах становится более эффективной и достигает 100 %. Более того, в низкоразмерных структурах со спин-орбитальным расщеплением подзон разнорного квантования спиновая ориентация носителей заряда может быть осуществлена линейно поляризованным и даже неполяризованным светом [6–8].

В этом случае механизм оптической ориентации является двухступенчатым и связан с асимметричным спин-зависимым фотовозбуждением, обусловленным правилами отбора, и последующей прецессией спинов в эффективном магнитном поле, индуцированном спин-орбитальным взаимодействием Рашбы или Дрессельхауз.

В последнее время интерес в изучении оптических свойств полупроводниковых систем сдвигается в сторону сверхбыстрых процессов. Благодаря прогрессу в технологии создания nanoструктур и развитию импульсных методик исследований, появилась возможность изучать спиновую динамику носителей заряда на пикосекундных и фемтосекундных масштабах времени, что привело к открытию новых режимов спиновой релаксации [9–14]. Было обнаружено, что в зависимости от соотношения между временем релаксации импульса электронов и периодом прецессии в эффективном магнитном поле либо происходит релаксация спина по классическому механизму Дьяконова–Переля [15, 16], либо возникают спиновые биения. В настоящей работе построена теория оптической ориентации электронных спинов в низкосимметричных квантовых ямах в условиях межзонного возбуждения короткими импульсами неполяризованного света. Показано, что через некоторое время после прохождения импульса в структу-

*E-mail: tarasenko@coherent.ioffe.ru

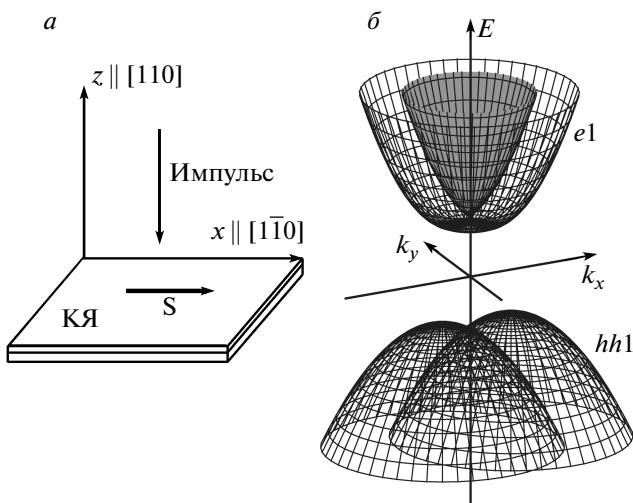


Рис. 1. а) Геометрия предполагаемого эксперимента; б) модельная зонная структура квантовой ямы (КЯ)

ре возникает спиновая поляризация, которая затем исчезает. Детальный расчет зависимости среднего спина электронов от времени проведен для асимметричных квантовых ям с кристаллографической ориентацией \$(110)\$, выращенных из полупроводников с решеткой цинковой обманки. Развитая теория справедлива для произвольного соотношения между периодом прецессии спина в эффективном магнитном поле и временем релаксации импульса электронов.

Геометрия предполагаемого эксперимента и модельная зонная структура квантовой ямы изображены на рис. 1. Неполяризованный или линейно поляризованный свет падает нормально на квантовую яму, выращенную вдоль оси \$z \parallel [110]\$, и вызывает оптические переходы между подзоной тяжелых дырок \$hh1\$ и электронной подзоной \$e1\$. В гетероструктурах \$(110)\$ эффективный гамильтониан, описывающий спин-орбитальное расщепление подзоны тяжелых дырок, содержит слагаемое, пропорциональное \$J_z k_x\$ [17], которое приводит к расщеплению подзоны \$hh1\$ на две ветви с проекциями углового момента \$\pm 3/2\$ на ось \$z\$. Ветви сдвинуты друг относительно друга вдоль оси \$k_x\$ (рис. 1б). Здесь \$J_z\$ — матрица \$4 \times 4\$, описывающая состояния с моментом \$3/2\$, \$\mathbf{k} = (k_x, k_y)\$ — двумерный волновой вектор, \$x \parallel [1\bar{1}0]\$ и \$y \parallel [00\bar{1}]\$ — координаты в плоскости квантовой ямы. Аналогичное спин-зависимое слагаемое в эффективном гамильтониане электронов обычно меньше; им для простоты пренебрегается. За счет линейного по \$k_x\$ расщепления подзоны \$hh1\$ и правил отбо-

ра межзонные оптические переходы приводят к появлению как электронов с проекцией спина \$+1/2\$ на ось \$z\$ преимущественно в состояниях с \$k_x > 0\$, так и частиц с противоположной проекцией спина в состояниях с \$k_x < 0\$. Непосредственно в момент фотовозбуждения спиновая поляризация электронов отсутствует, поскольку оптические переходы в состояния \$+1/2\$ и \$-1/2\$ под действием неполяризованного света идут с одинаковой вероятностью.

Средний спин электронов возникает в результате последующей прецессии спинов отдельных частиц в эффективном магнитном поле, обусловленном спин-орбитальным расщеплением подзоны \$e1\$ [6]. Будем считать для простоты, что это расщепление изотропно в \$\mathbf{k}\$-пространстве и связано со структурной асимметрией квантовой ямы (слагаемое Рашбы), см. рис. 1б. Эффективное магнитное поле Рашбы лежит в плоскости интерфейсов и вызывает прецессию электронных спинов, ориентированных сразу после действия оптического импульса вдоль нормали квантовой ямы, с ларморовой частотой \$\Omega_{\mathbf{k}}\$, соответствующей эффективному полю. Поскольку поле Рашбы является нечетной функцией волнового вектора и, в частности, \$\Omega_{k_x, y} = -\Omega_{-k_x, y}\$, направления вращения спинов противоположны для частиц с положительными и отрицательными значениями \$k_x\$. В результате прецессия спинов отдельных электронов в эффективном поле приведет к появлению отличной от нуля компоненты \$S_x\$ полного спина. Последующая спиновая динамика определяется соотношением между временем \$\tau\$ релаксации носителей по импульсу и периодом прецессии в эффективном поле. Если \$\tau \Omega_{\mathbf{k}} \gg 1\$ для характерных волновых векторов, то прецессия спинов отдельных электронов будет продолжаться и зависимость \$S_x\$ от времени будет содержать осцилляции. В противоположном предельном случае быстрая релаксация электронов по импульсу приведет к монотонному затуханию спина по механизму Дьяконова–Переля.

Отметим, что возможность возникновения электронного спина \$S_x\$ при накачке асимметричных квантовых ям с кристаллографической ориентацией \$(110)\$ неполяризованным светом следует также из соображений симметрии. Подобные структуры описываются точечной группой \$C_s\$, которая содержит единственный нетривиальный элемент — плоскость отражения \$yz\$. Отражение в этой плоскости не меняет компоненты псевдовектора \$S_x\$, поэтому \$S_x\$, как и скалярная величина интенсивности \$I\$ света, преобразуется по единичному представлению, что допускает феноменологическую связь \$S_x \propto I\$.

2. МЕЖЗОННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ

Микроскопическую теорию спиновой ориентации электронов импульсами неполяризованного света построим методом матрицы плотности. Одночастичная матрица плотности ρ электронов удовлетворяет квантовому кинетическому уравнению

$$i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = [H + V, \rho], \quad (1)$$

где H — невозмущенный гамильтониан системы,

$$V = -\frac{e}{m_0 c} \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}$$

— оператор взаимодействия электронов со световой волной, e — заряд электрона, m_0 — масса свободного электрона, c — скорость света, \mathbf{A} — векторный потенциал волны, \mathbf{p} — оператор импульса. Решение уравнения (1) можно представить в виде разложения ρ по оператору возмущения V :

$$\rho = \rho^{(0)} + \rho^{(1)} + \rho^{(2)} + \dots, \quad (2)$$

где $\rho^{(0)}$ — невозмущенная матрица плотности, удовлетворяющая уравнению

$$[H, \rho^{(0)}] = 0, \quad (3)$$

а поправки $\rho^{(k)}$ связаны друг с другом итерационными соотношениями

$$i\hbar \frac{\partial \rho^{(k)}}{\partial t} = [V, \rho^{(k-1)}] + [H, \rho^{(k)}]. \quad (4)$$

Предположим, что возбуждающий импульс имеет несущую частоту ω , а его огибающая описывается функцией Гаусса, т. е.

$$\mathbf{A} = (\mathbf{A}_0 e^{-i\omega t} + \mathbf{A}_0^* e^{i\omega t}) e^{-(t/t_0)^2}, \quad (5)$$

где A_0 и t_0 — характерные амплитуда и длительность импульса. В этом случае матричные элементы оператора возмущения в базисе собственных функций гамильтониана H примут вид

$$V_{nn'}(t) = [R_{nn'} e^{-i\omega t} + R_{n'n}^* e^{i\omega t}] e^{-(t/t_0)^2}, \quad (6)$$

где $R_{nn'} = -(e/m_0 c) \mathbf{A}_0 \cdot \mathbf{p}_{nn'}$, $\mathbf{p}_{nn'}$ — матричные элементы оператора импульса.

Будем считать, что до прихода оптического импульса валентная зона полностью заполнена электронами, зона проводимости пуста, а импульс вызывает оптические переходы между подзоной $hh1$ тяжелых дырок и электронной подзоной $e1$. В равновесном состоянии матрица плотности $\rho^{(0)}$ диагональна по собственным состояниям невозмущенного

гамильтониана. В первом порядке по возмущению V электромагнитная волна смешивает состояния валентной зоны и зоны проводимости, что приводит к появлению недиагональной по зонам матрицы плотности $\rho^{(1)}$. Компоненты матрицы плотности, отвечающие электронам в зоне проводимости, возникают во втором порядке по возмущению и содержатся в $\rho^{(2)}$. Решение уравнения (1) с точностью до второго порядка по V показывает, что матрица плотности электронов в подзоне $e1$ после прохождения оптического импульса принимает вид

$$\tilde{\rho}_{\beta\beta'} = \frac{\pi t_0^2}{2\hbar^2} \sum_n R_{\beta n} R_{\beta'n}^* \rho_{nn}^{(0)} \times \\ \times \left\{ \exp \left[-\frac{(\omega_{\beta n} - \omega)^2}{2} t_0^2 \right] + \right. \\ \left. + \exp \left[-\frac{(\omega_{\beta'n} - \omega)^2}{2} t_0^2 \right] \right\}, \quad (7)$$

где β и β' — индексы, нумерующие состояния в подзоне $e1$, n — индекс состояний валентной зоны, $\omega_{\beta n} = (E_\beta - E_n)/\hbar$ — энергетическое расстояние между уровнями β и n , разделенное на \hbar . При выводе формулы (7) предполагалось, что $|\omega_{\beta n} - \omega|$, $|\omega_{\beta'n} - \omega| \ll \omega$ и длительность импульса t_0 значительно меньше характерных времен релаксации электронов и $1/\Omega_{\mathbf{k}}$. В случае большой длительности импульса величина $\sqrt{2/\pi} \tilde{\rho}_{\beta\beta'}/t_0$ переходит в выражение для матрицы генерации электронов при стационарной оптической накачке [7].

В квантовых ямах с кристаллографической ориентацией (110) спектр электронов в подзоне $hh1$ с учетом вклада, пропорционального $J_z k_x$, в эффективный гамильтониан определяется выражением

$$E_{hh1,\pm 3/2} = -E_g - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_h} \pm \gamma k_x, \quad (8)$$

где E_g — эффективная ширина запрещенной зоны в квантовой яме, m_h — эффективная масса дырок в плоскости интерфейсов, γ — константа спин-орбитального расщепления. Стационарные волновые функции в подзоне $hh1$ имеют вид

$$\psi_{hh1,+3/2} = \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_\parallel) u_h(z) [-(X + iY)/\sqrt{2}] \uparrow, \quad (9)$$

$$\psi_{hh1,-3/2} = \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_\parallel) u_h(z) [(X - iY)/\sqrt{2}] \downarrow,$$

где \mathbf{r}_\parallel — координата в плоскости ямы, $u_h(z)$ — функция размерного квантования, X, Y — блоховские амплитуды, символы « \uparrow » и « \downarrow » обозначают спины, соответствующие состояниям с проекциями спина $+1/2$ и $-1/2$ на ось z .

Спектр электронов в подзоне $e1$ с учетом спин-орбитального расщепления Рашбы, обусловленного структурной асимметрией квантовой ямы, описывается выражением

$$E_{e1,\pm} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e} \pm \frac{\hbar}{2}\Omega_k, \quad (10)$$

где m_e — эффективная масса электронов, $\Omega_k = 2\alpha_R k/\hbar$ — частота прецессии спинов в эффективном магнитном поле, направление оси вращения определяется вектором $\Omega_{\mathbf{k}} = (2\alpha_R/\hbar)(k_y, -k_x, 0)$, α_R — константа Рашбы. Соответствующие стационарные волновые функции электронов имеют вид

$$\psi_{e1,\pm} = \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_{||}) u_e(z) S \chi_{\pm}, \quad (11)$$

где $u_e(z)$ — функция размерного квантования электронов в подзоне $e1$, S — блоховская амплитуда, $\chi_{\pm} = [\exp(-i\phi/2) \uparrow \mp i \exp(i\phi/2) \downarrow]/\sqrt{2}$ — спиноры, $\phi = \arctg(k_y/k_x)$ — азимутальный угол волнового вектора \mathbf{k} в полярной системе координат.

Межзонные матричные элементы $R_{\alpha\alpha}$ диагональны по волновому вектору \mathbf{k} и в базисе волновых функций (9) и (11) принимают вид

$$\begin{aligned} R_{e1,+; hh1,+3/2} &= \frac{eJP_{cv}}{2m_0c} (A_{0,x} + iA_{0,y}) e^{i\phi/2}, \\ R_{e1,+; hh1,-3/2} &= -\frac{eJP_{cv}}{2m_0c} (A_{0,y} + iA_{0,x}) e^{-i\phi/2}, \\ R_{e1,-; hh1,+3/2} &= \frac{eJP_{cv}}{2m_0c} (A_{0,x} + iA_{0,y}) e^{i\phi/2}, \\ R_{e1,-; hh1,-3/2} &= \frac{eJP_{cv}}{2m_0c} (A_{0,y} + iA_{0,x}) e^{-i\phi/2}, \end{aligned} \quad (12)$$

где $J = \int u_e(z) u_h(z) dz$ — интеграл перекрытия, $P_{cv} = \langle S | p_x | X \rangle$ — межзонный матричный элемент оператора импульса.

Расчет по формуле (7) с использованием матричных элементов (12) показывает, что спиновая матрица плотности электронов в подзоне $e1$ после прохождения короткого ($t_0 \ll \tau, 1/\Omega_k$) неполяризованного оптического импульса определяется выражением

$$\tilde{\rho} = \pi \left| \frac{eA_0 t_0 JP_{cv}}{2m_0 c \hbar} \right|^2 \begin{pmatrix} d_+ + d_- & d_+ - d_- \\ d_+ - d_- & d_+ + d_- \end{pmatrix}, \quad (13)$$

где

$$d_{\pm} = \exp \left[- \left(E_g + \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu} \mp \gamma k_x - \hbar\omega \right)^2 \frac{t_0^2}{2\hbar^2} \right], \quad (14)$$

$\mu = m_e m_h / (m_e + m_h)$ — приведенная масса. Матрица плотности (13) представлена в базисе спиноров χ_{\pm} .

Она описывает функции распределения электронов, $f_{\mathbf{k}} = \text{Tr} \tilde{\rho} / 2$, и электронных спинов, $\mathbf{S}_{\mathbf{k}} = \text{Tr} \tilde{\sigma} \tilde{\rho} / 2$, в \mathbf{k} -пространстве, где компоненты матриц $\tilde{\sigma}$ определяются соотношениями $\tilde{\sigma}_{ss'} = \chi_s^{\dagger} \sigma \chi_{s'}$, σ — вектор, составленный из матриц Паули, $s, s' = \pm$. Расчет показывает, что $f_{\mathbf{k}}$ и $\mathbf{S}_{\mathbf{k}}$ сразу после прохождения оптического импульса имеют вид

$$f_{\mathbf{k}}(0) = \pi \left| \frac{eA_0 t_0 JP_{cv}}{2m_0 c \hbar} \right|^2 (d_+ + d_-), \quad (15)$$

$$S_{\mathbf{k},z}(0) = \pi \left| \frac{eA_0 t_0 JP_{cv}}{2m_0 c \hbar} \right|^2 (d_+ - d_-), \quad (16)$$

$S_{\mathbf{k},x}(0), S_{\mathbf{k},y}(0) = 0$. Выражение (16) описывает нечетное по k_x распределение спиновой плотности в \mathbf{k} -пространстве. Отличный от нуля средний спин электронов появляется и затем исчезает в результате спиновой релаксации данного неравновесного распределения.

3. СПИНОВАЯ ДИНАМИКА

В простом приближении времени релаксации спиновая динамика электронов описывается кинетическим уравнением [3]

$$\frac{d\mathbf{S}_{\mathbf{k}}}{dt} + \mathbf{S}_{\mathbf{k}} \times \boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{k}} = -\frac{\mathbf{S}_{\mathbf{k}} - \langle \mathbf{S}_{\mathbf{k}} \rangle}{\tau}, \quad (17)$$

где $\langle \mathbf{S}_{\mathbf{k}} \rangle$ — электронный спин, усредненный по направлениям волнового вектора \mathbf{k} , τ — время изотропизации функции распределения электронов в импульсном пространстве. В уравнении (17) пренебрегается энергетической релаксацией и рекомбинацией электронов с дырками; эти процессы предполагаются медленными по сравнению с τ и временем спиновой релаксации. Для нахождения зависимости среднего спина электронов от времени после прохождения оптического импульса необходимо решить уравнение (17) с начальным условием (16).

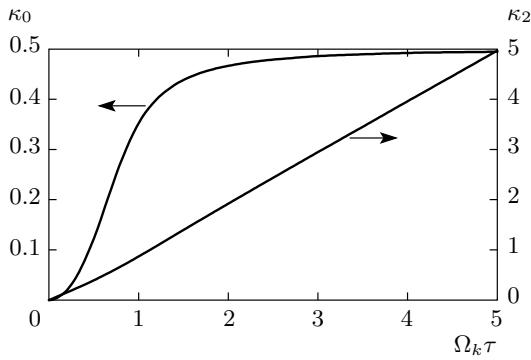
Уравнение (17) удобно решить, разложив функцию распределения $\mathbf{S}_{\mathbf{k}}$ электронных спинов и частоту $\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{k}}$ по угловым гармоникам:

$$\mathbf{S}_{\mathbf{k}} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathbf{S}^{(m)} e^{im\phi}, \quad (18)$$

$$\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{k}} = \boldsymbol{\Omega}^{(1)} e^{i\phi} + \boldsymbol{\Omega}^{(1)*} e^{-i\phi}, \quad (19)$$

и сделав замену переменных

$$S_{\pm}^{(m)} = S_x^{(m)} \pm iS_y^{(m)},$$

Рис. 2. Зависимости величин κ_0 и κ_2 от $\Omega_k \tau$

где

$$\Omega_x^{(1)} = -\frac{i\Omega_k}{2}, \quad \Omega_y^{(1)} = -\frac{\Omega_k}{2}, \quad \Omega_z^{(1)} = 0.$$

Подстановка рядов (18) и (19) в уравнение (17) показывает, что компонента $S_{+}^{(0)}$, описывающая средний спин электронов в плоскости ямы, связана системой линейных дифференциальных уравнений только с компонентами $S_z^{(-1)}$ и $S_z^{(-2)}$:

$$\begin{aligned} \frac{dS_{+}^{(0)}}{dt} + \Omega_k S_z^{(-1)} &= 0, \\ \frac{dS_z^{(-1)}}{dt} - \frac{\Omega_k}{2} [S_{+}^{(0)} + S_{-}^{(-2)}] &= -\frac{S_z^{(-1)}}{\tau}, \\ \frac{dS_{-}^{(-2)}}{dt} + \Omega_k S_z^{(-1)} &= -\frac{S_{-}^{(-2)}}{\tau}. \end{aligned} \quad (20)$$

Аналогичная система уравнений справедлива для гармоник $S_{-}^{(0)}$, $S_z^{(+1)}$ и $S_{+}^{(+2)}$. Решение системы (20) можно представить в виде

$$\begin{pmatrix} S_{+}^{(0)} \\ S_z^{(-1)} \\ S_{-}^{(-2)} \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^3 C_j \begin{pmatrix} -\Omega_k \tau / \lambda_j \\ 1 \\ -\Omega_k \tau / (\lambda_j + 1) \end{pmatrix} \times \exp\left(\frac{\lambda_j t}{\tau}\right), \quad (21)$$

где C_j — коэффициенты, которые определяются начальными условиями, λ_j — корни характеристического уравнения

$$(2\lambda + 1)(\Omega_k \tau)^2 + 2\lambda(\lambda + 1)^2 = 0. \quad (22)$$

Уравнение (22) имеет в общем случае три различных корня, λ_1 , λ_2 и λ_3 , которые удобно выразить через два вещественных параметра, κ_0 и κ_2 , определяющих соответственно декременты затухания и частоту осцилляции решений:

$$\lambda_1 = -\kappa_0, \quad \lambda_{2,3} = -1 + \kappa_0/2 \pm i\kappa_2. \quad (23)$$

Зависимости κ_0 и κ_2 от параметра $\Omega_k \tau$ представлены на рис. 2. При $\Omega_k \tau \ll 1$ коэффициенты κ_0 и κ_2 малы: $\kappa_0 \approx (\Omega_k \tau)^2/2$, $\kappa_2 \approx \Omega_k \tau / \sqrt{2}$. В этом случае величина $-\lambda_1/\tau \approx \Omega_k^2 \tau / 2$ характеризует скорость релаксации среднего спина электронов в плоскости квантовой ямы [16], а величина $-\lambda_{2,3}/\tau \approx 1/\tau$ — скорость изотропизации функции распределения электронных спинов в импульсном пространстве. В противоположном предельном случае, когда $\Omega_k \tau \gg 1$, коэффициенты κ_0 и κ_2 имеют соответственно асимптотики $1/2$ и $\Omega_k \tau$ и корни характеристического уравнения $\lambda_{2,3}/\tau = \pm i\Omega_k$ соответствуют частоте прецессии спинов в эффективном магнитном поле.

Сразу после прохождения оптического импульса функция распределения спинов (16) в импульсном пространстве содержит только угловые гармоники $S_z^{(n)}$ с нечетным n , причем $S_z^{(n)} = S_z^{(-n)}$. Из решения (21) и аналогичного решения для компонент $S_{-}^{(0)}$, $S_z^{(+1)}$ и $S_{+}^{(+2)}$ следует, что последующая прецессия спинов в эффективном магнитном поле приводит к появлению отличных от нуля гармоник $S_{+}^{(0)} = S_{-}^{(0)}$, т. е. к возникновению среднего спина вдоль оси x . С учетом соотношений (23) окончательное выражение для зависимости $S_x^{(0)}(t)$ принимает вид

$$S_x^{(0)}(t) = \frac{\Omega_k \tau}{2} \left\{ K \left[\exp\left(\frac{\lambda_2 t}{\tau}\right) - \exp\left(\frac{\lambda_1 t}{\tau}\right) \right] + \text{c.c.} \right\} S_z^{(1)}(0), \quad (24)$$

где K — комплексный безразмерный параметр, зависящий от корней характеристического уравнения,

$$K = \frac{2 - i\kappa_0/\kappa_2}{2 - 3\kappa_0 - 2i\kappa_2}, \quad (25)$$

$S_z^{(1)}(0)$ — первая гармоника функции распределения спинов, созданная оптическим импульсом. Разложение функции распределения (16) по угловым гармоникам дает следующее выражение для $S_z^{(1)}(0)$ в линейном приближении по константе спин-орбитального расщепления подзоны тяжелых дырок:

$$S_z^{(1)}(0) = \pi \frac{\gamma k \varepsilon t_0^2}{\hbar^2} \left| \frac{e A_0 t_0 J P_{cv}}{2 m_0 c \hbar} \right|^2 \exp\left(-\frac{\varepsilon^2 t_0^2}{2 \hbar^2}\right), \quad (26)$$

где $\varepsilon = E_g + \hbar^2 k^2 / 2\mu - \hbar\omega$.

Выражение (24) определяет временную зависимость спина электронов с определенным значением модуля волнового вектора \mathbf{k} . Полный спин электронов может быть найден интегрированием $S_x^{(0)}(t)$ по всем значениям k .

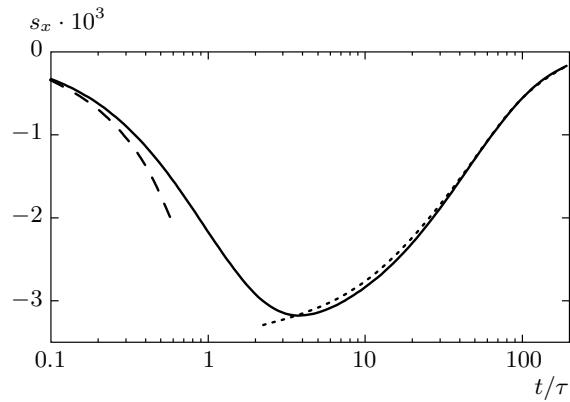


Рис. 3. Зависимость среднего спина s_x от времени, рассчитанная для $\alpha_R/\hbar = 10^5$ см/с и $t_0 = 10^{-13}$ с (сплошная кривая). Штриховой и пунктирной кривыми показаны асимптотики при малых и больших временах, построенные по формулам (28) и (29)

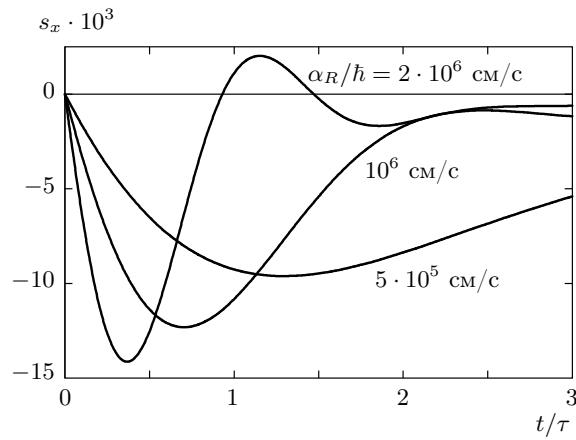


Рис. 4. Зависимости среднего спина s_x от времени, рассчитанные для $t_0 = 10^{-13}$ с и различных значений константы спин-орбитального расщепления в подзоне $e1$

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 3–5 представлены зависимости среднего спина электронов

$$s_x(t) = \frac{1}{2\pi N_e} \int_0^\infty S_x^{(0)}(t) k dk \quad (27)$$

от времени при возбуждении структуры (в момент времени $t = 0$) коротким неполяризованным оптическим импульсом. В формуле (27) $N_e = 2 \sum_{\mathbf{k}} f_{\mathbf{k}}(0)$ — концентрация электронов, созданных оптическим импульсом; предполагается, что после импульса кон-

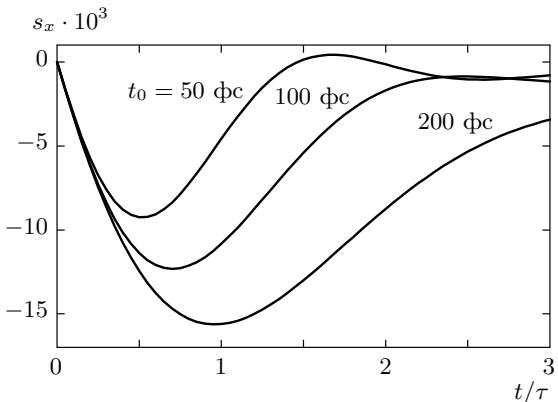


Рис. 5. Зависимости среднего спина s_x от времени, рассчитанные для $\gamma/\hbar = \alpha_R/\hbar = 10^6$ см/с и различных длительностей импульса накачки t_0

центрация постоянна на масштабах времен спиновой релаксации. Зависимости построены для несущей частоты оптического импульса $\omega = E_g/\hbar$, времени изотропизации $\tau = 10^{-12}$ с, приведенной массы $\mu = 0.04m_0$, константы линейного по \mathbf{k} расщепления подзоны тяжелых дырок $\gamma/\hbar = 10^6$ см/с, различных значений расщепления Рашбы электронной подзоны α_R/\hbar от 10^5 до $2 \cdot 10^6$ см/с и длительностей оптического импульса t_0 от 0.5 до $2 \cdot 10^{-13}$ с. При данных параметрах импульса характерное значение волнового вектора фотоэлектронов составляет $q \sim \sqrt{2\mu/t_0\hbar} \sim 10^6$ см $^{-1}$.

В случае малого расщепления подзоны $e1$ (рис. 3, $\alpha_R/\hbar = 10^5$ см/с, $t_0 = 10^{-13}$ с, что соответствует $\Omega_q\tau \approx 0.2$) спин электронов быстро нарастает после прохождения оптического импульса, достигает максимального значения при $t \sim \tau$ и затем медленно убывает. Анализ выражений (24) и (27) показывает, что линейный рост спина происходит на временах $t \ll \tau$ и описывается выражением

$$s_x(t) \approx -\frac{\alpha_R \gamma \mu}{\hbar^3} t. \quad (28)$$

Уменьшение спиновой поляризации при $t > \tau$ обусловлено спиновой релаксацией, которая идет с различной скоростью для электронов с различными значениями k . При $t \gg \tau$ зависимость $s_x(t)$ имеет вид

$$s_x(t) \approx -\frac{\alpha_R \gamma \mu \tau}{\hbar^3} F \left(\frac{4\sqrt{2} \alpha_R^2 \mu \tau t}{t_0 \hbar^3} \right), \quad (29)$$

где

$$F(x) = \left(1 + \frac{x^2}{2} \right) \left[1 - \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2} \right) \right] \exp \left(-\frac{x^2}{4} \right) - \frac{x}{\sqrt{\pi}},$$

$\text{erf}(y)$ — функция ошибок. Асимптотические зависимости среднего спина от времени, (28) и (29), построены на рис. 3 штриховой и пунктирной кривыми. Видно, что приближенные функции хорошо соглашаются с точным расчетом в соответствующих интервалах времен.

Отметим, что аргумент функции F в формуле (29) представляет собой с точностью до численного коэффициента отношение $t/T_s(q)$, где $T_s(q) = 2/\Omega_q^2\tau$ — время спиновой релаксации электронов с волновым вектором $q = \sqrt{2\mu/t_0\hbar}$. Разложение функции $F(x)$ в ряд и анализ функции $s_x(t)$ при $t \gg T_s(q) \gg \tau$ не представляются нам актуальными, поскольку процессы энергетической релаксации электронов, не учитываемые в настоящей работе, будут менять характер зависимости $s_x(t)$ на больших временах. Кроме того, энергетическая релаксация носителей заряда в низкосимметричных квантовых ямах сама по себе может приводить к частичной спиновой поляризации носителей [18].

При больших значениях спинового расщепления электронной подзоны (рис. 4) зависимость среднего спина электронов от времени после импульса накачки имеет сложный немонотонный характер и содержит осцилляции. Такое поведение обусловлено прецессией спинов фотоэлектронов в эффективном магнитном поле Рашбы. Величина $|s_x(t)|$ в максимумах достигает нескольких процентов от максимального значения $1/2$, частота осцилляций увеличивается с ростом величины расщепления.

На рис. 5 представлены зависимости среднего спина от времени, рассчитанные для фиксированного спинового расщепления подзон $e1$ и $hh1$, но для различных длительностей t_0 оптического импульса. Видно, что зависимости $s_x(t)$, в том числе и максимальные значения спиновой поляризации, различны для разных значений t_0 , а одинаковое поведение функции $s_x(t)$ имеет место только при малых временах.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе развита теория оптической ориентации электронных спинов ультракороткими импульсами неполяризованного света в низкосимметричных квантовых ямах. Показано, что степень спиновой поляризации фотовозбужденных электронов через некоторое время после прохождения оптического импульса может достигать нескольких процентов. Характер спиновой динамики электронов зависит от соотношения между временем τ изотропизации функции распределения и частотой Ω_q прецессии спинов фотоэлектронов в эффективном магнит-

ном поле. При $\Omega_q\tau \ll 1$ средний спин электронов быстро нарастает после прохождения оптического импульса, достигает максимального значения и затем медленно убывает за счет процессов спиновой релаксации. В противоположном случае, $\Omega_q\tau \gg 1$, зависимость среднего спина от времени имеет осцилляционный характер.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 11-02-00348, 11-02-91346-ННИО), Министерства образования и науки РФ (ГК 14.740.11.0892) и фонда «Династия».

ЛИТЕРАТУРА

1. *Optical Orientation*, ed. by Y. Kusrayev and G. Landwehr, Special issue Semicond. Sci. Technol. **23** (2008).
2. *Spin Physics in Semiconductors*, ed. by M. I. Dyakonov, Springer-Verlag, Berlin (2008).
3. *Optical Orientation*, ed. by F. Meier and B. P. Zakharchenya, Elsevier Science, Amsterdam (1984).
4. И. А. Меркулов, В. И. Перель, М. Е. Портной, ЖЭТФ **99**, 1202 (1991).
5. И. А. Акимов, Д. Н. Мирлин, В. И. Перель, В. Ф. Сапега, ФТП **35**, 758 (2001).
6. S. A. Tarasenko, Phys. Rev. B **72**, 113302 (2005).
7. С. А. Тарасенко, ФТТ **49**, 1704 (2007).
8. Sh. Crankshaw, F. G. Sedgwick, M. Moewe et al., Phys. Rev. Lett. **102**, 206604 (2009).
9. M. A. Brand, A. Malinowski, O. Z. Karimov et al., Phys. Rev. Lett. **89**, 236601 (2002).
10. W. J. H. Leyland, R. T. Harley, M. Henini et al., Phys. Rev. B **76**, 195305 (2007).
11. В. Н. Гриднев, Письма в ЖЭТФ **74**, 417 (2001).
12. Н. С. Аверкиев, М. М. Глазов, ФТП **42**, 973 (2008).
13. D. Stich, J. Zhou, T. Korn et al., Phys. Rev. Lett. **98**, 176401 (2007).
14. M. Griesbeck, M. M. Glazov, T. Korn et al., Phys. Rev. B **80**, 241314 (2009).
15. М. И. Дьяконов, В. И. Перель, ФТТ **13**, 3581 (1971).
16. М. И. Дьяконов, В. Ю. Качоровский, ФТП **20**, 178 (1986).
17. E. L. Ivchenko and G. Pikus, *Superlattices and Other Heterostructures: Symmetry and Optical Phenomena*, Springer, Berlin (1997).
18. S. A. Tarasenko, ФТП **42**, 982 (2008).